

Procedeu de obținere a peliculelor subțiri de semiconductoare oxidice de In_2O_3 , care include depunerea peliculelor prin piroliză spray la temperatura de 450...550°C din soluții apoase de InCl_3 cu concentrația sării de metal din soluție ce depășește 0,2M cu recoacerea ulterioară în atmosferă neutră sau cu conținut de oxigen la o temperatură nu mai mică de 1000°C.